

Содержание

• Электронные свойства полупроводников

Газизов И.М., Залетин В.М., Говорков А.В., Кузнецов М.С., Лисицкий И.С., Поляков А.Я., Смирнов Н.Б.

Центры рекомбинации и прилипания в чистых и легированных кристаллах PbVg 1153

Осинных И.В., Журавлев К.С., Малин Т.В., Бер Б.Я., Казанцев Д.Ю.

Уменьшение энергии связи доноров в слоях GaN:Si при сильном легировании 1164

Гаджалиев М.М., Пирмагомедов З.Ш., Эфендиева Т.Н.

Температурная и магнетопольная зависимости термоэдз электронного антимонида индия 1169

Гайдар Г.П.

Кинетика электронных процессов в γ -облученных (^{60}Co) монокристаллах $n\text{-Ge}$ 1171

Стрельчук В.В., Авраменко Е.А., Романюк А.С., Завьялова Л.В., Свечников Г.С., Хомченко В.С., Рощина Н.Н., Ткач В.Н.

Структурные и оптические свойства пленок ZnO , полученных безвакуумным химическим методом 1176

Мехтиева С.И., Исаев А.И., Атаева С.У., Зейналов В.З.

Особенности локальной структуры халькогенидного стеклообразного полупроводника $\text{Se}_{95}\text{Te}_5$, легированного самарием 1182

Бакланов А.В., Гуткин А.А., Брунков П.Н., Егоров А.Ю., Конников С.Г.

Анализ процессов термической эмиссии электронов из массивов InAs квантовых точек в слое объемного заряда GaAs -матрицы 1186

• Спектроскопия, взаимодействие с излучениями

Махний В.П., Слетов А.М., Стец Е.В.

Природа голубой полосы излучения в ZnSe с изовалентной примесью S 1192

• Поверхность, границы раздела, тонкие пленки

Боднарь И.В.

Ширина запрещенной зоны твердых растворов $(\text{FeIn}_2\text{S}_4)_{1-x}(\text{In}_2\text{S}_3)_x$ 1194

• Полупроводниковые структуры, низкоразмерные системы, квантовые явления

Котина И.М., Данишевский А.М., Коньков О.И., Теруков Е.И., Тухконен Л.М.

Сбор фотоносителей в высокоомных кремниевых аморфно-кристаллических гетероструктурах 1198

Мостовой А.И., Брус В.В., Марьянчук П.Д.

Механизмы токопереноса в гетероструктурах на основе тонких пленок $\text{TiO}_2:\text{Cr}_2\text{O}_3$ 1205

Талалаев В.Г., Цырлин Г.Э., Горай Л.И., Новиков Б.В., Лабзовская М.Э., Tomm J.W., Werner P., Fuhrmann B., Schilling J., Rases P.N.

Влияние наномостиков на спектр излучения туннельной пары квантовая точка–квантовая яма 1209

Павлов Н.В., Зегря Г.Г.

Оптические свойства гетероструктур с глубокими квантовыми ямами $\text{AlSb/InAs}_{0.84}\text{Sb}_{0.16}/\text{AlSb}$ 1217

Тыщенко И.Е., Фельсков М., Черков А.Г., Попов В.П.

Ионный синтез нанокристаллов InSb в захороненном слое SiO_2 структуры кремний-на-изоляторе 1228

• Микро- и нанокристаллические, пористые, композитные полупроводники

Дмитриевский А.А., Ефремова Н.Ю., Дружкин А.В., Коростелева Т.О., Гусева Д.Г.

Влияние длительности электрохимического анодирования на микротвердость макропористого кремния 1234

Свит К.А., Протасов Д.Ю., Свешникова Л.Л., Шестаков А.К., Тийс С.А., Журавлев К.С.

Туннельный транспорт через массивы пассивированных нанокристаллов CdS , полученных методом Ленгмюра–Блоджетт 1237

Улин В.П., Улин Н.В., Солдатенков Ф.Ю., Семенов А.В., Бобыль А.В.

Поверхность пористого кремния в процессах гидрофилизации и гидролитической деградации 1243

• Физика полупроводниковых приборов

Андреев В.М., Гребенщикова Е.А., Дмитриев П.А., Ильинская Н.Д., Калиновский В.С., Контрош Е.В., Малевская А.В., Усикова А.А.

Влияние постростовых технологий на характеристики трехпереходных солнечных элементов InGaP/Ga(In)As/Ge 1249

Tsai Jung-Hui, Wu You-Ren, Chiang Chung-Cheng, Wang Fu-Min, Liu Wen-Chau

Influence of gate-to-source and gate-to-drain recesses on GaAs camel-like gate field-effect transistors 1254

**Васильевский И.С., Виниченко А.Н., Грехов М.М.,
Гладков В.П., Каргин Н.И., Стриханов М.Н.**

Технология и электронные свойства РНЕМТ-квантовых
ям $\text{AlGaAs}/\text{In}_{y(z)}\text{Ga}_{1-y(z)}\text{As}/\text{GaAs}$ с переменным профилем
состава 1258

• **Изготовление, обработка, тестирование материалов
и структур**

**Аскеров Э.Б., Мададзада А.И., Исмаилов Д.И., Мех-
тиева Р.Н.**

Взаимодействие гетерогенных тонких пленок и образова-
ние фаз в системе Pt-Fe-S 1265

Крылов П.Н., Закирова Р.М., Федотова И.В.

Влияние ионно-лучевой обработки в процессе реактивного
высоочастотного магнетронного распыления на концен-
трацию и подвижность носителей заряда в пленках ПТО . 1269

**Достанко А.П., Агеев О.А., Голосов Д.А., Завад-
ский С.М., Замбург Е.Г., Вакулов Д.Е., Вакулов З.Е.**

Электрические и оптические свойства пленок оксида цинка,
нанесенных методом ионно-лучевого распыления оксидной
мишени 1274

**Хвостиков В.П., Сорокина С.В., Потапович Н.С.,
Солдатенков Ф.Ю., Тимошина Н.Х.**

Температурная стабильность контактных систем фотоэлек-
трических преобразователей на основе GaSb 1280

**Закгейм Д.А., Иткинсон Г.В., Кукушкин М.В., Мар-
ков Л.К., Осипов О.В., Павлюченко А.С., Смирно-
ва И.П., Черняков А.Е., Бауман Д.А.**

Мощные светодиодные кристаллы AlGaInN с двухуровне-
вой металлизацией 1287

• **Персоналии**

Аскеров Бахрам Мехрали оглы 1294